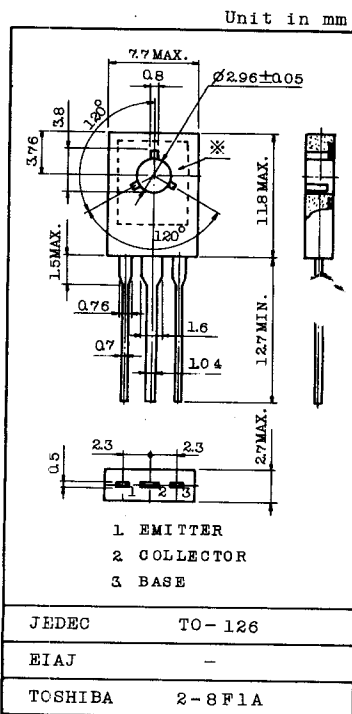


- 中電力増幅用
- 励振段増幅用
 - Medium Power Amplifier Applications
 - Driver Stage Amplifier Applications
- ・ 高耐压です : $V_{CEO} = -80V$
- ・ 高出力 Hi-Fi Amp. の励振段に適します。
- ・ 2SC1382 とコンプリメンタリになります。
- ・ Complementary to 2SC1382



※点線内のメタルはコレクタに接続されています。

The inside metal of dotted line is connected to collector lead.

アクセサリはAC46Cを適用
MOUNTING KIT No. AC46C

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-750	mA
エミッタ電流	I_E	750	mA
コレクタ損失	P_C	800	mW
接合温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~150	°C

※ PCT 技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

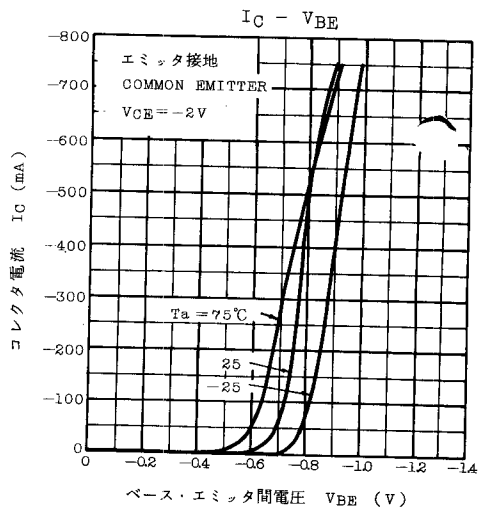
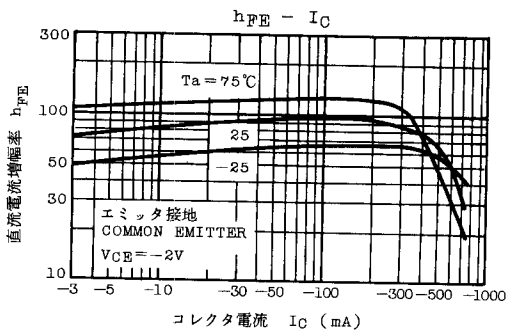
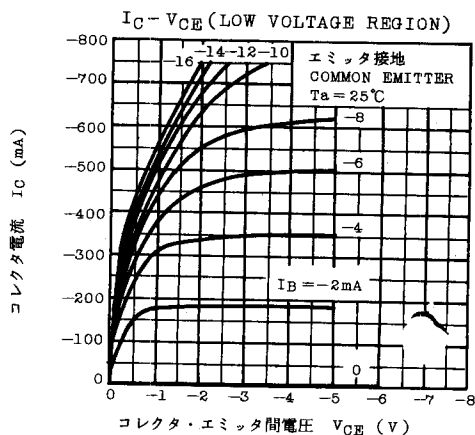
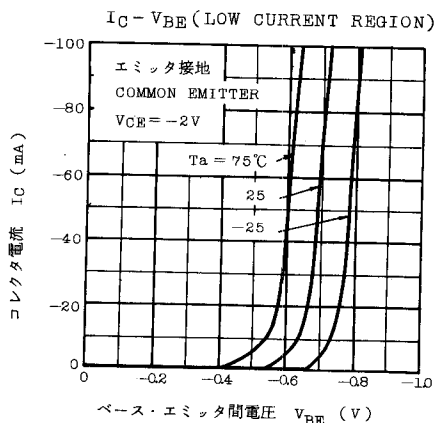
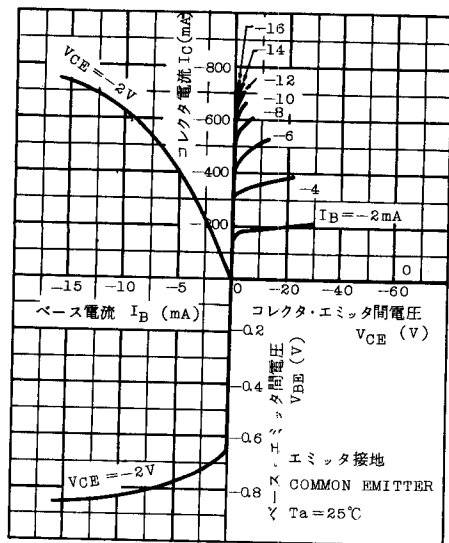
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -30\text{V}, I_E = 0$	-	-	-0.1	μA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = 0$	-	-	-1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10\text{mA}, I_B = 0$	80	-	-	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -0.1\text{mA}, I_C = 0$	5	-	-	V
流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -150\text{mA}$	70	-	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -500\text{mA}$	40	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500\text{mA}, I_B = -50\text{mA}$	-	-	-0.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -500\text{mA}$	-	-	-1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -150\text{mA}$	50	100	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0$ $f = 1\text{MHz}$	-	15	-	pF

Note: $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

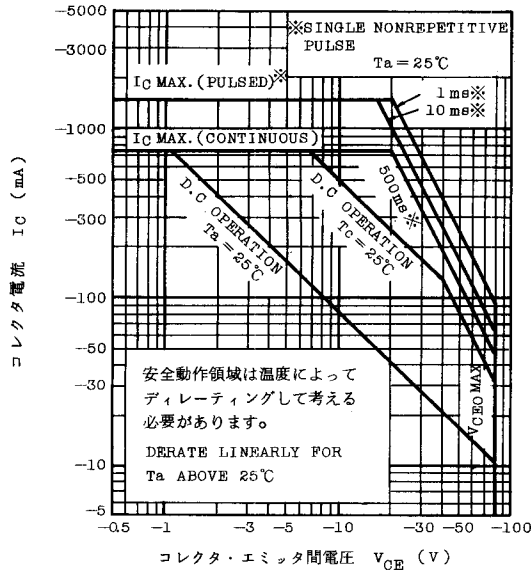
According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SA682 is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SA682 - 0	70	140
2SA682 - Y	120	240

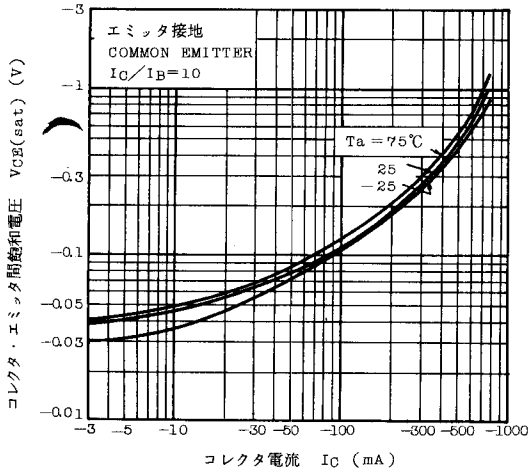
STATIC CHARACTERISTICS



安全動作領域 ASO



$V_{CE(sat)} - I_C$



$P_C - T_a$

